1. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas, apimantis bent vieną elementą (1), iš kurio suformuotas korpusas, apimantis viršutinį dangtį (2), skaidrų regimojoje spektro srityje, apatinę plokštę (3) ir bent du elektrodus (4a, 4b), kuriuos galima prijungti prie elektros generatoriaus (5), kur korpuso viduje yra skystis (6), skaidrus regimojoje spektro srityje ir pilnas dalelių (7),

kur viršutinis dangtis (2) ir skystis (6) yra skaidrūs bangų ilgio srityje nuo 2,5 mikrometrų iki 20 mikrometrų;

kur elektrodai (4a, 4b) laikosi ant apatinės plokštės ir atspindi infraraudonosios spektro srities spindulius;

kur elektrodai (4a, 4b) yra nesimetriški, pirmasis elektrodas (4a) apima pirmąjį paviršiaus plotą, antrasis elektrodas (4b) apima antrąjį paviršiaus plotą, pirmasis paviršiaus plotas yra didesnis už antrąjį paviršiaus plotą ir kur dalelės (7) yra nanometrinio dydžio bei apima bent vieną medžiagą, kurią galima įkrauti elektra, tad jų elektrokinetinis potencialas nėra nulinis, kur dalelių dydis parinktas taip, kad jos sugertų infraraudonuosius spindulius bangų ilgio srityje nuo 2,5 mikrometro iki 20 mikrometrų.

2. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elektrodai (4a, 4b) dengia ne mažiau kaip 90 % apatinės plokštės (3) paviršiaus ploto.

3. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pirmasis paviršiaus plotas dešimt kartų didesnis už antrąjį paviršiaus plotą.

4. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elektrodai (4a, 4b) yra skaidrūs regimojoje spektro srityje.

5. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elektrodai (4a, 4b) suformuoti iš pakaitomis išdėstytų lygiagrečių juostelių (Bi, bi), kur pirmasis elektrodas (4a) apima plačias juosteles (Bi), o antrasis elektrodas (4b) apima siauras juosteles (bi), kur dvi viena po kitos išdėstytos plačios juostelės atskirtos viena nuo kitos siaura juostele.

6. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad juostelės (Bi, bi) apima pakaitomis išdėstytus plyšius ir plokšteles.

7. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plyšiai ir plokštelės yra stačiakampio formos.

8. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plyšiai ir juostelės yra trikampio formos.

9. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–8 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad medžiaga, kurią galima įkrauti, yra metalu legiruotas metalo oksidas, kur medžiagos dalelių dydis 40–80 nanometrų.

10. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad medžiaga, kurią galima įkrauti, parinkta iš grupės, apimančios aliuminiu legiruotą aliuominio oksidą (Al: ZnO), galiu legiruotą cinko oksidą (Ga: ZnO), indžiu legiruotą cinko oksidą (Ga: ZnO), niobiu legiruotą titano oksidą (Nb: TiO2), alavu legiruotą indžio oksidą (ITO).

11. Infraraudonųjų spindulių atspindžio gebos reguliavimo prietaisas pagal 10 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad medžiagos, esančios skystyje (6), koncentracija yra 10–60 mg/ml.